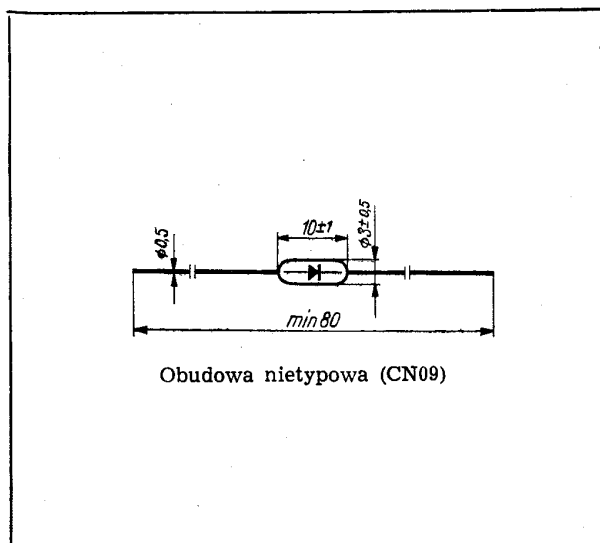


DIODY IMPULSOWE
 ○ BAY54, BAY55, BAP661

Diody krzemowe epiplanarne.

Diody BAY54 i BAY55 są przeznaczone do stosowania w układach przełączających o bardzo dużej szybkości działania.

Diody BAP661 są przeznaczone do stosowania w układach detekcyjnych.



DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych

| | | BAP661 | BAY54 i 55 | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----|
| Napięcie wsteczne | U_R | 25 | 50 | V |
| Szczytowe napięcie wsteczne | U_{RM} | 30 | 50 | V |
| Prąd przewodzenia | I_F | 100 | 115 | mA |
| Szczytowy prąd przewodzenia | I_{FM} | 180 | 225 | mA |
| Temperatura złącza | t_j | 423 K (150°C) | | |
| Zakres temperatury składowania | t_{stg} | 218...423 K (-55...+150°C) | | |

SWW 1156-131

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

| | | min. | typ. | maks. | | |
|---|------------|---------------------|------|-------|---------|---------|
| Napięcie przewodzenia przy $I_F = 50$ mA | U_F | | | | | |
| | | dla BAY55 | — | 0,9 | 1 | V |
| | | BAY54 | — | 1,1 | 1,2 | V |
| $I_F = 15$ mA | | | | | | |
| | | dla BAP661 | — | 0,8 | 1 | V |
| Prąd wsteczny przy $U_R = 30$ V | I_R | | | | | |
| | | dla BAY54 i 55 | — | 1,5 | 50 | nA |
| | | $U_R = 25$ V | | | | |
| | | dla BAP661 | — | 50 | 500 | nA |
| | | $U_R = 30$ V | | | | |
| $U_R = 25$ V | | | | | | |
| | | dla BAY54 i 55 | — | 1 | 50 | μ A |
| $U_R = 30$ V | | | | | | |
| | | dla BAP661; | | | | |
| $t_{amb} = 632$ K (150°C) | | — | 5 | 50 | μ A | |
| Napięcie przebicia przy $I_R = 5$ μ A | $U_{(BR)}$ | | | | | |
| | | dla BAY54 i 55 | 50 | 70 | — | V |
| | | $I_R = 100$ μ A | | | | |
| dla BAP661 | 30 | 45 | — | V | | |

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

| | | min. | typ. | maks. | | |
|--|-------|------|------|-------|---|----|
| Czas przełączania dla BAY54 i 55 przy $I_F = 10$ mA; $t_{rr} = 1$ mA; $U_R = 6$ V; t_{rr} $R_L = 100$ Ω | | | | | | |
| | | | — | 1,8 | 2 | ns |
| | | | | | | |
| Ładunek magazynowany dla BAY54 i 55 przy $I_F = 10$ mA; $U_R = 5$ V | Q_s | | | | | |
| | | | — | 35 | — | pC |
| Pojemność diody dla BAY54 i 55 przy $f = 1$ MHz; $U_R = 0$ | C_T | | | | | |
| | | | — | 1 | 2 | pF |
| Sprawność detekcji dla BAP661 przy $f = 35$ MHz; $U_{eff} = 3$ V; $R = 100$ k Ω ; $C = 150$ pF | | | | | | |
| | | | — | 85 | — | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |